

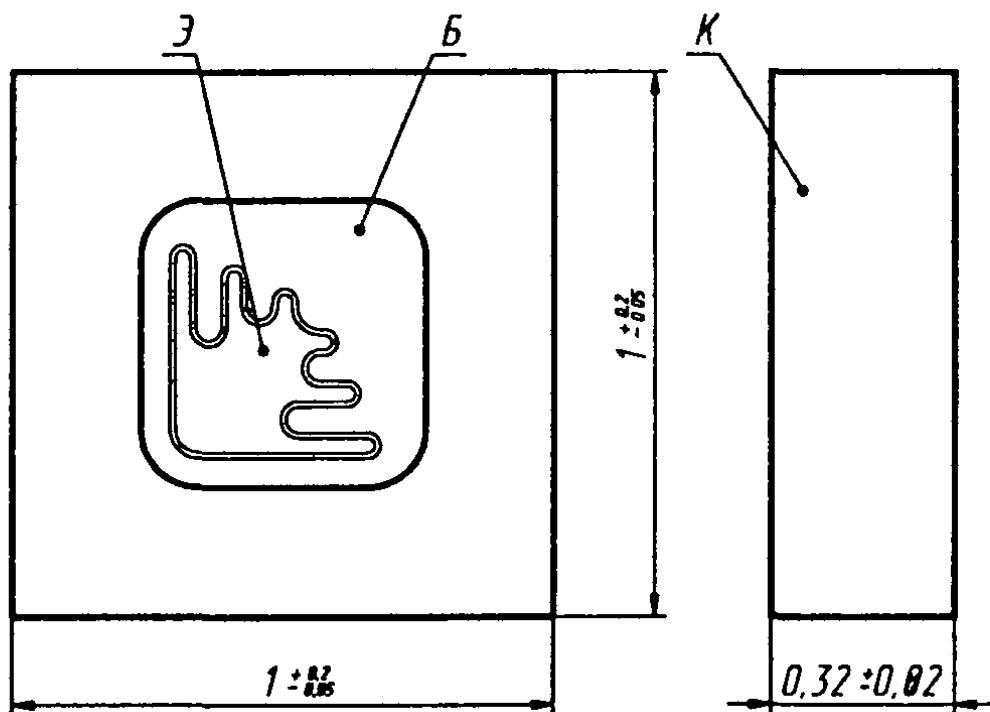
**2T630A, 2T630B, 2T630A-5,
KT630A, KT630B, KT630B, KT630G, KT630D, KT630E**

Транзисторы кремниевые планарные структуры *p-p-p* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах, в схемах управления газоразрядной панелью переменного тока, силовых каскадах ключевых стабилизаторов и преобразователей. Транзисторы 2T630A, 2T630B, KT630A-KT630E выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Транзистор 2T630A-5 выпускается в виде неразделенных кристаллов на пластине с контактными площадками для гибридных интегральных микросхем. Тип прибора указывается в этикетке.

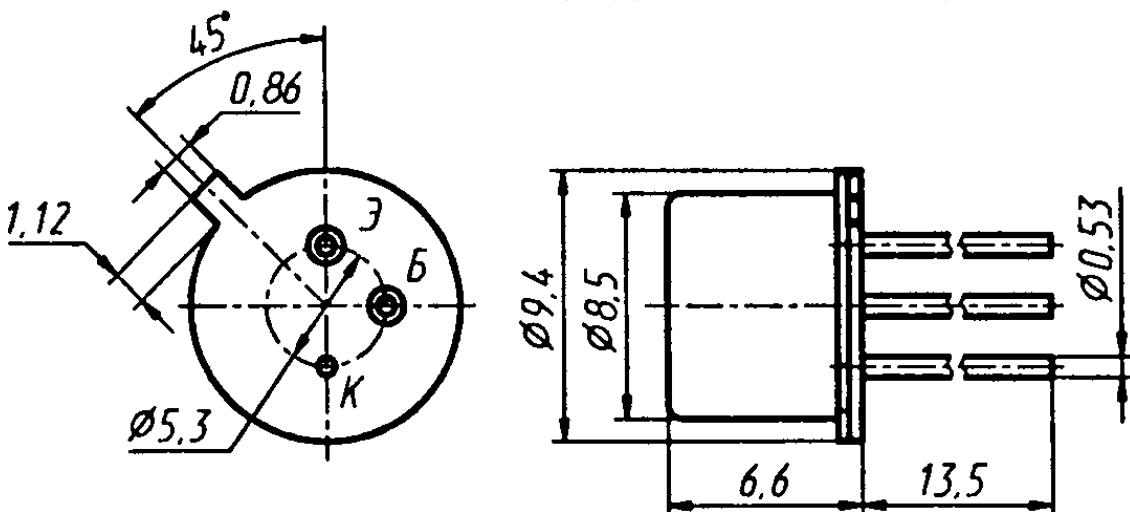
Масса транзистора в металлокерамическом корпусе не более 2 г, кристалла не более 0,005 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний»,
г. Брянск.

2T630A-5



2T630(A,B), KT630(A-E)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10$ В, $I_k = 150$ мА:

$T = +25$ °С:

2T630A, 2T630A-5, KT630A, KT630B, KT630Г	40...120
2T630Б, KT630Б, KT630Д	80...240
KT630Е	160...480

$T = +125$ °С:

2T630A, 2T630A-5	30...150
2T630Б	70...300
KT630A, KT630B, KT630Г	40...240
KT630Б, KT630Д	80...480
KT630Е	120...1000

$T = -60$ °С:

2T630A, 2T630A-5, KT630A, KT630B, KT630Г	15...120
2T630Б, KT630Б, KT630Д	30...240
KT630Е	40...480

Границная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 10$ В, $I_k = 60$ мА,
не менее 50 МГц

Граничное напряжение:

при $I_3 = 100$ мА, $t_u = 300$ мкс, $Q = 200$,
не менее:

2T630A, 2T630A-5	90 В
2T630Б	80 В

при $I_3 = 30$ мА, $t_H = 100$ мкс, $Q = 200$,
не менее:

КТ630А	90 В
КТ630Б, КТ630В	80 В
КТ630Д, КТ630Е	40 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА, не более	0,3 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА, не более	1,1 В
Время включения при $I_K = 200$ мА, $I_B = 40$ мА.	0,04...0,1... 0,25 мкс
Время выключения при $I_K = 200$ мА, $I_B = 40$ мА.	0,08...0,2... 0,5 мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 10$ В, не более	15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0,5$ В, не более	65 пФ
Входное сопротивление в режиме малого сигнала на низкой частоте в схеме ОЭ при $U_{KE} = 10$ В, $I_K = 5$ мА.....	200...500... 1200 Ом
Входное сопротивление в режиме малого сигнала на низкой частоте в схеме ОБ при $U_{KE} = 10$ В, $I_K = 5$ мА.....	5...6...8 Ом
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 90$ В ($U_{KB} = 40$ В для КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е), не более:	
2T630А, 2T630Б, КТ630А—КТ630Е	1 мкА
2T630А—5	100 мкА
Обратный ток эмиттера, не более:	
при $U_{EB} = 5$ В:	
2T630А, 2T630Б.....	0,1 мкА
КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	100 мкА
при $U_{EB} = 7$ В для 2T630А, 2T630Б, 2T630А—5, КТ630Б, КТ630В	100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

$R_{БЭ} = 3 \text{ кОм}$:

2T630A, 2T630B, 2T630A-5, KT630A,	
KT630B	120 В
KT630B	150 В
KT630Г	100 В
KT630Д, KT630Е	60 В

$R_{БЭ} = \infty$:

2T630A, 2T630A-5, KT630A, KT630B ..	90 В
2T630B, KT630B	80 В
KT630Г	60 В
KT630Д, KT630Е	40 В

Постоянное напряжение коллектор—база:

2T630A, 2T630B, 2T630A-5, KT630A,	
KT630B	120 В
KT630B	150 В
KT630Г	100 В
KT630Д, KT630Е	60 В

Постоянное напряжение эмиттер—база:

2T630A, 2T630B, 2T630A-5, KT630A,	
KT630B, KT630B	7 В
KT630Г, KT630Д, KT630Е	5 В

Постоянный ток коллектора

1 А

Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 100 \text{ мкс}$

2 А

Постоянный ток базы

0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹:

при $T = -60 \dots +25^\circ\text{C}$

0,8 Вт

при $T = +125^\circ\text{C}$

0,15 °C

Температура $p-n$ перехода

+150 °C

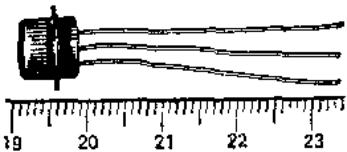
Температура окружающей среды

-60 ... +125 °C

¹ При $T > +25^\circ\text{C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора уменьшается линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не выше +260 °C в течение не более 3 с.



KT630А, KT630Б, KT630В, KT630Г,
KT630Д, KT630Е

Общие сведения. Кремниевые планарные $n-p-n$ -транзисторы используются в быстродействующих импульсных и других схемах.

Электрические параметры. Классификационные параметры:

$U_{\text{КЭО гр}}, h_{21\beta}, U_{\text{КЭР max}}, U_{\text{ЭБО max}}, U_{\text{КБО max}}$.

Наименование	Обозна- чение	Значения			Режимы измерения				
		мини- мальное	типовое	макси- мальное	$U_{\text{К}} \cdot \text{В}$	$U_{\beta} \cdot \text{В}$	$I_{\text{К}} \cdot \text{мА}$	$I_{\text{Б}} \cdot \text{мА}$	$I_{\text{Э}} \cdot \text{мА}$
Обратный ток коллектора, мкА: KT630А—KT630В KT630Г—KT630Е	$I_{\text{КБО}}$			1 1	90 40				
Граничное напряжение транзистора ($I_{\text{Б}} = 0$), В: KT630А KT630Б, KT630В KT630Г KT630Д, KT630Е	$U_{\text{КЭО гр}}$	90							100
		80							100
		60							100
		40							100

Наименование	Обозна- чение	Значения			Режимы измерения					
		мини- мальное	типовое	макси- мальное	$U_{K\cdot}$, В	$U_{\beta\cdot}$, В	$I_{K\cdot}$, мА	$I_{B\cdot}$, мА	$I_{\beta\cdot}$, мА	f , кГц
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, В	$U_{K\beta\text{ нас}}$		0,11	0,3			150	15		
Напряжение насыщения база — эмиттер, В	$U_{B\beta\text{ нас}}$		0,85	1,1			150	15		
Входное сопротивление транзистора в схеме с общей базой в режиме малого сигнала, Ом	$h_{11\beta}$	5	6	8	10				5	0,27
Входное сопротивление транзистора в схеме с ОЭ в режиме малого сигнала, Ом	$h_{11\beta}$	200	500	1200	10		5			0,27
Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ: KT630A, KT630B, KT630Г KT630Б, KT630Д KT630Е при $T_c = +125^\circ\text{C}$: KT630A, KT630B, KT630Г KT630Б, KT630Д KT630Е	$h_{21\beta}$	40 80 160	80 150 290	120 240 480	10 10 10		150 150 150			
Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ, МГц	$f_{\text{гр}}$	50			10				50	20
Время включения ($t_a = -10$ мкс), мкс	$t_{\text{вкл}}$	0,04	0,1	0,25			200	40		
Время выключения ($t_a = -10$ мкс), мкс	$t_{\text{выкл}}$	0,08	0,2	0,5			200	40		
Емкость эмиттерного перехода, пФ	C_a			65		0,5				300
Емкость коллекторного перехода, пФ	C_K			15	10					10^4

Максимально допустимые параметры. Гарантируются при температуре окружающей среды $T_c = -40 \dots +125^\circ\text{C}$.

$I_{K\max}$ — постоянный ток коллектора, А 1
 $I_{B\max}$ — постоянный ток базы, А 0,2

* KT630A—KT630B 7
KT630Г—KT630Е 5

$U_{KBO\max}$ — постоянное напряжение коллектор — база, В;
KT630А, KT630Б 120
KT630В 150
KT630Г 100
KT630Д, KT630Е 60

$U_{KE\max}$ — постоянное напряжение коллектор — эмиттер ($R_B \leq 3 \text{ кОм}$), В:

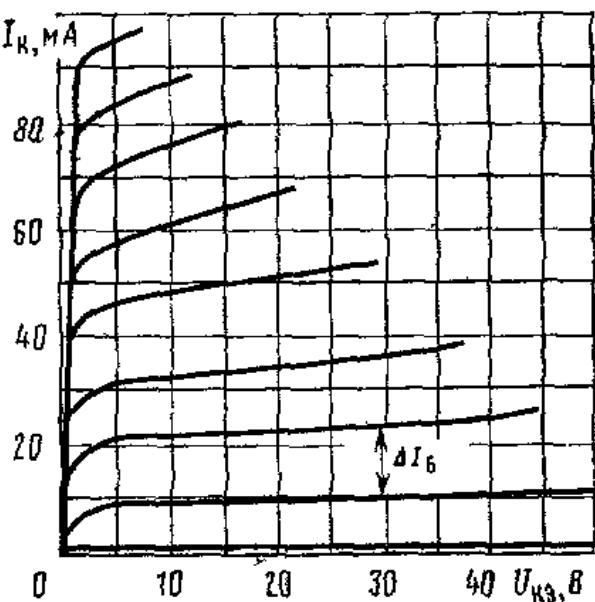
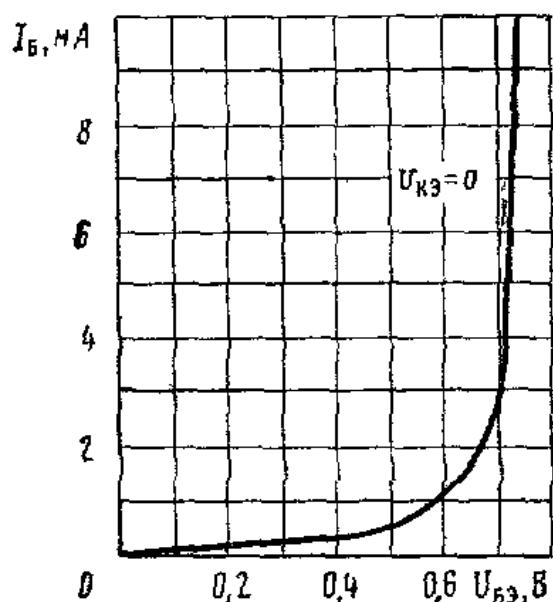
¹⁾ При повышении температуры $25 \dots 150^\circ\text{C}$ мощность уменьшается линейно на 6,4 мВт на 1°C .

$I_{K, \alpha\max}$ — импульсный ток коллектора, А 2
 $U_{EBO\max}$ — постоянное напряжение эмиттер — база, В;

KT630А, KT630Б 120
KT630В 150
KT630Г 100
KT630Д, KT630Е 60

$P_K^{(1)}$ — постоянная рассеиваемая мощность коллектора ($T_c = +25^\circ\text{C}$), Вт 0,8

$T_{\alpha\max}$ — температура перехода, $^\circ\text{C}$ > 150
Допустимая температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$ $-40 \dots +125$



KT630А, KT630В, KT630Д — $\Delta I_B = 120 \text{ мА}$; KT630Б,
KT630Г — $\Delta I_B = 65 \text{ мА}$; KT630Е — $\Delta I_B = 35 \text{ мА}$

